

神戸大理

<u>石浦宏尚</u>,身内賢太朗,橋本隆,池田智法, 中村拓馬,越智敦彦,中村輝石,伊藤博士

2019/03/14 日本物理学会 第74回年次大会

発表Outline

>NEWAGE

▶陰イオンµ-TPC (NIµ-TPC)

≻陰イオンガス中MPGD特性

≻GEM基礎測定

≻陰イオンガス中MPGDシミュレーション

≻暗黒物質探索に向けて

≻結論

NEWAGE

> **NEWAGE** (NEw general WIMP search with an Advanced Gaseous tracker Experiment)

3次元ガス飛跡検出器(µ-TPC)を用いた方向に感度を持つ暗黒物質直接探索実験 → 暗黒物質により原子核反跳されたフッ素原子核の飛跡をとらえる



GEM, µ-PIC : MPGD(Micro Pattern Gaseous Detector)の一種

陰イオンµ-TPC(NIµ-TPC)

4



陰イオンガス中MPGD特性

5

基礎測定としてSF₆ガス(陰イオンガス)中GEMガスゲインを測定

▶ 100 µ m GEM 2 or 3段を用いてガス圧、印加電圧を変え測定



2段/3段GEM 測定結果

2 段/3段GEMの結果から<u>1段当たり</u>のゲイン計算(100 Torr)



▶ 1段GEMシミュレーションを行いゲインカーブを再現

陰イオンガス中MPGDシミュレーション

Garfield++: 陰イオンからの電子脱離プロセス含まれず

→**陰イオンからの電子脱離プロセス**を組み込む必要

- ▶電子脱離のモデルとして
 - 1) 実験結果から推定したトイモデル

GEM中電場 40~50kV/cm @100Torr で脱離(実験より) 40~50kV/cm付近で電子脱離確率が立ち上がるモデル(右下図 赤線)

2) 電子脱離電場依存モデル(右下図)

電子脱離反応断面積から構築した

(ξ=1青 or ξ=10マゼンダ)

を用いてシミュレーション

反応に必要なエネルギー ϵ 平均自由行程 λ から反応の起こる電場E ξ は自由パラメータとして $E = \xi \epsilon / \lambda$



電子離脱の反応

- $SF_6^- + SF_6 \to F^- + SF_5 + SF_6$ (5.4)
- $SF_5^- + SF_6 \to F^- + SF_4 + SF_6$ (5.5)
 - $F^- + SF_6 \to e^- + F + SF_6$ (5.6)

シミュレーション結果

- 1) 40~50kV/cmの電場付近で電子脱離確率が立ち上がるトイモデル(赤■)
 ▶ 実験で得られたゲインカーブとGarfield++を用いた再現
- 2) 電子離脱の反応断面積を考慮したモデル(青▲、マゼンダ▼)

▶ 反応断面積モデルではトイモデルと実験値に比べ、傾き小



反応断面積モデルは低電場でも電子脱離が起き、増幅長がトイモデルより長く **→傾きに違い**

電子脱離確率電場依存モデルのパラメータ再考の必要性



MPGD描像&シミュレーションから

- ・ ガスゲイン/エネルギー分解能の理解→ エネルギー閾値へ
- ・メイン&マイノリティチャージ検出向上→有効体積カット など運用条件最適化
 大型NIµ-TPC実現&最適化へ

暗黒物質探索に向けて

10

▶ µ-PIC の低アルファ化 (橋本隆博士論文、14pK203-9池田智法 Talk)従来(NEWAGE2015)に比べ感度約10倍 を達成 (NEWAGE2019 preliminary)





▶ 今後

> 理解した特性+シミュレーションを用いてMPGD/TPCの選定&改良
> 陰イオンガスµ-TPC開発、暗黒物質探索感度向上へ

▶ まとめ

- ➤ NEWAGE:方向感度を持つ暗黒物質探索
 - ▶ 検出器由来α線バックグランドで感度制限→低減必要
 - ▶バックグランド低減のため陰イオンガスTPC開発中
- ▶ 陰イオンガスTPC開発・改良のためMPGD基礎特性を研究
 ▶ GEMの基礎測定
 - ▶シミュレーション手法を開発、ゲインカーブを概ね再現 →陰イオンガス中MPGD描像理解を進めた